

RFT SY180/1 ... 14

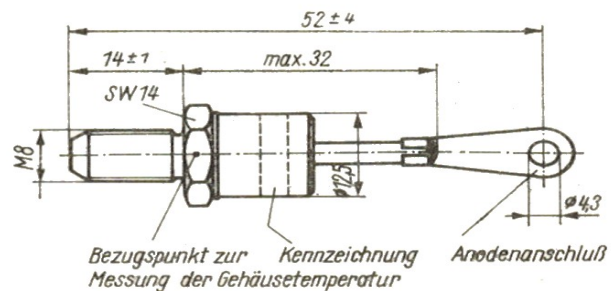
Silizium-Leistungsdiode im Metallgehäuse mit Gewindeanschluss M8

Typ	$U_{RRM}^{1)}$ (V)	$U_{RSM}^{2)}$ (V)	U_{RWM} (V)	U_R	$I_{F(AV)}^{3)}$ (A)	$I_{F(RMS)}$ (A)	$I_{FSM}^{4)}$ (A)
SY180/1	100		70		30	47	420
SY180/2	200		140				
SY180/4	400		280				
SY180/6	600		420				
SY180/8	800		560				
SY180/10	1000		700				
SY180/12	1200		840				
SY180/14	1400		980				

- Sperrschichttemperatur -55°C bis 150°C

- www.semicon-data.de
- 1) $\frac{t_P}{T}$ (von U_R) \leq 0,5; $f=50\text{Hz} \dots 400\text{Hz}$
 - 2) t_P \leq 20mS
 - 3) Sinushalbwellen, ϑ_C = 100°C
 - 4) Sinushalbwelle, f = 40Hz ... 65Hz, ϑ_j = 150°C

1mal biegen der Fahne um 90° zulässig; Stellung der Fahne zum Sechskant unverbindlich



Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985